

Əmirova Səbinə İkrəm qızı



Амирова Сабина Икрам кызы.

Кандидат физико-математических наук. Преподаватель кафедры Физической электроники.

Рабочий номер: 99412-539-73-73.

E-mail: sbn.amirova@mail.ru

Краткая биография: Родилась 5 ноября 1977 года в городе Баку. Окончив школу №20, получила образование на физическом факультете Бакинского Государственного Университета. Замужем, имеет двоих детей.

Образование, научная степень:

1998г-студентка Физического факультета специальности Физическая электроника БГУ.

2000-магистр по специальности «Физика плазмы» Физического факультета.

2008-защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Электронные процессы в тонких пленках твердых растворов типа $Cd_{1-x}Zn_xS_{1-y}Se$ и структурах на их основе».

Трудовая деятельность:

2000-2004 - старший лаборант на кафедре Физической электроники Физического Факультета БГУ.

С 2004года - преподаватель на кафедре Физической электроники Физического факультета БГУ.

Преподаваемые дисциплины:

Общая физика,

Твердотельная электроника,

Оптоэлектроника,

Физическая электроника.

Количество статей - более 30.

Проводимые исследования:

Изучение электронных процессов в тонких пленках и структурах на их основе.

Участие в международных семинарах, симпозиумах и конференциях:

2006, 2007, 2008 - весенний семинар Европейского Научно-исследовательского общества, Страсбург, Франция.

2006- Международная научно-техническая конференция «Фотоэлектроника и приборы ночного видения», Москва, Россия.

2006- Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники», Таганрог, Россия.

2013- VII Республиканская Научно-практическая конференция на тему «Опто-, наноэлектроника и физика высоких энергий», Баку.

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ

1. Температурная зависимость подвижности носителей заряда в чистых и легированных гадолинием кристаллах $P-GaAs$. Неорганические материалы, 2012, т.48, в.6, с.649-653

2. Управление электрическим полем параметрами и характеристиками фотоприемников на основе слоистых кристаллов A^{III}B^{VI}. Труды международной конференции по фотоэлектронике и приборам ночного видения. Москва, 2012, Б 55, с.327-328
3. Влияние температуры и легирования редкоземельными элементами на подвижность носителей заряда в кристаллах моноселенида индия. Физика и техника полупроводников, Санкт-Петербург, 2013, том 47, вып.8, ст.1009-1013
4. К вопросу о происхождении и возможностях управления нестабильностей параметров негатронных элементов на основе слоистых кристаллов A^{III}B^{VI}. Материалы седьмой международной научно-технической конференции «Микроэлектронные преобразователи и приборы на их основе». МЭПП. 2013. с. 135-136.
5. К вопросу об аномальных поведении электрофизических параметров слоистых кристаллов A^{III}B^{VI} в области низких температур. «Фундаментальные и прикладные вопросы физики». Труды Международной Конференции, посвященной 70-летию Физико-технического института НПО «Физика-Солнце» АН РУз. Ташкент. Узбекистан. 2013. С.58-59.
6. Влияние температуры и легирования редкоземельными элементами на электрофизические параметры кристаллов моноселенида галлия. Неорганические материалы. Москва. 2014, том 50, №4, с.362-367
7. Влияние света на подвижность свободных носителей заряда в кристаллах моноселенида индия. Физика и техника полупроводников, Санкт-Петербург. 2014, том 48, вып. 8. С. 1009-1013
8. Приемники ИК-излучения на основе моноселенида галлия. Труды XXIII Международной научно-технической конференции по фотоэлектронике и приборам ночного видения. Май 2014. Москва. С.242-246
9. Приемники ИК-излучения на основе моноселенида галлия. Прикладная физика, 2015, Москва. № 5. С. 67-71
10. Фотопроводимость частично-неупорядоченных кристаллических полупроводников типа соединений A^{III}B^{VI} со слоистой структурой. Сборник тезисов докладов международной конференции «Фундаментальные и прикладные вопросы физики». Ташкент. 2015. С.84-86
11. К вопросу об электрофизических свойствах монокристаллов n-InSe. Физика и техника полупроводников, 2016, Санкт-Петербург. том 50, вып. 1. С. 35-38